




## ФИЗИКА – МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

	<p>Ф.И.О.: Исмаилов Шавкат Козиевич</p> <p>ДОЛЖНОСТЬ: Доцент</p> <p>ТЕЛ: +998999617524</p> <p>Е – mail: <a href="mailto:shavkat6819@mail.ru">shavkat6819@mail.ru</a></p> <p>ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ: +99862 2246700</p> <p>АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14. 220100</p>
<p><b>ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1985 - 1990 гг. - Ташкентский государственный университет, физический факультет, студент;</li> <li>• 1981–1992 гг. - Институт математики УзФА, стажер-исследователь;</li> <li>• 1998 - 2001 гг. - Физико-технический институт УзФА, аспирант.</li> </ul>
<p><b>ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1993 - 1998 - УрГУ, стажер-преподаватель,</li> <li>• 2001 - 2008 гг. - Ургенчский государственный университет, ассистент,</li> <li>• 2008 - настоящее время - доцент кафедры «Физика» Ургенчского государственного университета.</li> </ul>
<p><b>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Физика полупроводников и диэлектриков.</li> </ul>
<p><b>ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Термодинамика и статическая физика, Теоретическая механика, Молекулярная физика, Микроэлектроника.</li> </ul>
<p><b>ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выращивание и исследование электронных и оптических свойств твердых растворов <math>(Ge_2)_{1-x}(InP)_x</math> (<math>0 \leq x \leq 1</math>).</li> </ul>
<p><b>ПРОЕКТЫ:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выращивание кристаллические совершенных Si – SiGe–(Ge)<sub>1-x</sub>(InP)<sub>x</sub> структур из жидкой фазы. Письма в ЖТФ, 1999, том 25, вып. 24, стр. 37-40.</li> <li>2. Токопрохождение в <math>pSi_{1-x} - Ge_x - n(Ge_2)_{1-x} (InP)_x</math> структурах. ДАН РУз. Ташкент, 2005, № 2 стр. 23-25.</li> <li>3. Optical Properties of <math>(Ge_2)_{1-x} (InP)_x</math> Solid Solution. Technical Physics Letters, 2006, vol. 32, № 6. pp. 538-541.</li> <li>4. Электронная структура твердого раствора <math>(Ge_2)_{1-x} (InP)_x</math>, УФЖ, Ташкент, 2006, № 6. УФЖ, Ташкент, 2006, № 6.</li> <li>5. Оптические свойства твердого раствора <math>(Ge_2)_{1-x} (InP)_x</math>. Письма в ЖТФ 2006, т. 32, вып 12, 63-70 стр</li> <li>6. Электронная структура твердого раствора <math>(Ge_2)_{1-x} (InP)_x</math>. // УзФЖ, Ташкент, 2007, № 1.</li> <li>7. Прогноз процессов льдаобразования в водных ресурсах Хорезмского оазиса. Илм сарчашмалари 2011, 9-сон, 56-58 б.</li> <li>8. Киришмаларнинг кристалл музда эрувчанлигига масаласига доир. Илм сарчашмалари журналы 2012 й. N 2</li> <li>9. Выращивание эпитаксиальных слоев <math>(Sn_2)_x (InSb)_{1-x}</math> на GaAs подложке из</li> </ol>

	<p>жидкой фазы. Илм сарчашмалари журналы, 2016 г. №8</p> <p>10. Яримўтказгичлар ва диэлектриклар физикаси фанидан электрон ўқув модули ишланмасини яратиш. Илм сарчашмалари 2016 й. № 12</p> <p>11. Simulation of parametrs of nGe-pSiGe diode structures on TCAD SENTAURUS. “Actual problems modern science education end training in the region” Electronic scientific edited volume 1. 2017 42-46 p.</p> <p>12. Жидкофазная эпитаксия твердых растворов (Ge<sub>2</sub>)<sub>1-x</sub>(InP)<sub>x</sub> и (GaAs)<sub>1-x-y</sub>(Ge<sub>2</sub>)<sub>(ZnSe)<sub>y</sub></sub>. “Технологии Техника Инженерия” Международный научный журнал № 2.1 (4.1) / 2017 г., стр.28-30</p> <p>13. О зонной структуре твердого раствора Ge<sub>1-x</sub> Sn<sub>x</sub>. Образования и воспитания, Международный научный журнал № 3.1 (18.1) / 2018 г., стр.</p>
<p><b>ПУБЛИКАЦИИ</b></p>	<p>1. Яримўтказгичлар ва диэлектриклар физикаси фанидан электрон ўқув модули ишланмасини яратиш. Илм сарчашмалари 2016 й. № 12</p> <p>2. Simulation of parametrs of nGe-pSiGe diode structures on TCAD SENTAURUS. “Actual problems modern science education end training in the region” Electronic scientific edited volume 1. 2017 42-46 p.</p> <p>3. Жидкофазная эпитаксия твердых растворов (Ge<sub>2</sub>)<sub>1-x</sub>(InP)<sub>x</sub> и (GaAs)<sub>1-x-y</sub>(Ge<sub>2</sub>)<sub>(ZnSe)<sub>y</sub></sub>. “Технологии Техника Инженерия” Международный научный журнал № 2.1 (4.1) / 2017 г., стр.28-30</p> <p>4. О зонной структуре твердого раствора Ge<sub>1-x</sub> Sn<sub>x</sub>. Образования и воспитания, Международный научный журнал № 3.1 (18.1) / 2018 г., стр.</p>